

日程表 (分科別1)

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】就活生必見！ 未来への挑戦状 ～先端半導体が拓く未来社会のビジョン～			61B 09:15 ~ 11:45					
NT2【一般公開】若手・氷河期世代・女性研究者の声はどこまで届いているか？ ～男女共同参画学協会連絡会による大規模アンケートに基づいた要望・提言～								1BN 13:00 ~ 17:00
T1 21世紀の科学者・技術者の育成のあり方 ～組織における人材育成・技術伝承～		61A 13:30 ~ 17:30						
T2【一般公開】放射線教育・市民科学に向けた検出器開発								1BL 13:30 ~ 16:40
T3【一般公開】応用物理がもたらすメタバースの臨場感（第3弾）						71A 09:00 ~ 11:30		71A 13:00 ~ 16:00
T4 レーザー改質プロセスの基礎と先端技術		1BN 13:30 ~ 17:50						
T5 分極反転光材料・デバイスの発展と応用				71B 13:30 ~ 18:20				
T6【一般公開】量子エレクトロニクス研究会 50周年記念シンポジウム						71A 13:30 ~ 17:00		
T7 ハイブリッド材料・システムによる革新的光・スピン計測						1BL 13:30 ~ 18:00		
T8 3次元空間光センシングの最前線						61A 13:30 ~ 17:00		
T9 酸化物材料の圧電デバイス応用		61B 13:30 ~ 17:20						
T10 バイオメテックスとセンサー・AI ～自然から学び、未来を創る～				61B 13:30 ~ 16:15				
T11 Beyond Graphene						1BJ 13:30 ~ 17:45		
T12『運用開始直前企画』ナノテラスの活用をお教えします！						61B 13:30 ~ 17:10		
T13 プラズマが拓くナノ粒子・量子ドットの新展開				71A 13:30 ~ 18:20				
T14 磁場を利用した分析技術の最前線		1BJ 13:30 ~ 16:50						
T15 スピントロニクス実用技術：トンネル磁気抵抗研究とメモリ応用の最前線						71B 13:30 ~ 17:25		
T16 フュージョンエネルギーはカーボンニュートラル実現の鍵となるか？		1BL 13:30 ~ 18:00						
T17【一般公開】ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサー最前線 - ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能な グラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -		1BM 13:30 ~ 17:15						
T18【一般公開】有機薄膜太陽電池の社会実装に向けて必要なこと：ヘロボスカイト太陽電池との共通基盤技術	22C 10:00 ~ 11:40	22C 13:00 ~ 15:45						
T19 古くて新しい自己組織化・自己集積化						1BM 13:30 ~ 17:05		
T20 ロボテクス・未来医療に向けたバイオデバイス研究の最前線						1BN 13:30 ~ 17:20		
T21【一般公開】実装技術アラカルト：最先端半導体実装技術の挑戦と将来展望		71A 13:30 ~ 17:30						
T22 未来を拓く多元系化合物の様々な機能性と物性		71B 13:30 ~ 16:45						
T23 応用電子物性分科会設立80周年記念シンポジウム				1BL 13:30 ~ 18:10				
T24 IoT市場拡大に資する半導体産業の進展とコア技術とは？		61C 13:30 ~ 16:35						
T25 深紫外光デバイスの進展						61C 13:00 ~ 16:30		
T26 エネルギーハーベスティングのフロンティア -GXに挑戦する若手研究者たち-			61A 09:00 ~ 11:40	61A 13:00 ~ 15:10				
T27【一般公開】インフォマテックスが明らかにする材料と脳			61C 09:00 ~ 11:45	61C 13:00 ~ 16:35				
FS フォーカストセッション「AI/Eレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AI/Eレクトロニクス」			P09 09:30 ~ 11:30	22B 13:00 ~ 16:45	31A 09:00 ~ 11:30	31A 13:00 ~ 17:00	31A 09:00 ~ 11:30	31A 13:00 ~ 15:45
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会					1BB 09:00 ~ 12:00	1BB 13:30 ~ 18:15		
KS.2 量子情報工学研究会		12C 13:00 ~ 18:00					P06 09:30 ~ 11:30	
KS.3 半導体グリーンファブ研究会 ※16.2 エナジーハーベスティングとのコードシェアセッション (CS.10)					12B 09:00 ~ 12:15			
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション						12B 13:30 ~ 17:45		
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					13P 09:00 ~ 10:45			
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						11F 16:15 ~ 18:45		
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション				11E 13:30 ~ 16:15				
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスのコードシェアセッション	11E 09:30 ~ 12:00							
CS.6 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション							1BJ 09:00 ~ 11:30	1BJ 13:00 ~ 14:45
CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション				12G 13:30 ~ 17:30				
CS.8 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートとのコードシェアセッション						12J 15:45 ~ 18:00		
CS.9 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション (タンデム)								22C 13:00 ~ 16:00
CS.10 16.2 エナジーハーベスティング、KS.3 半導体グリーンファブ研究会のコードシェアセッション						12B 09:00 ~ 12:15		

日程表 (分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
1 応用物理学一般									
1.1 応用物理一般・学際領域				P05 16:00 ~ 18:00	12C 09:00 ~ 09:30				
1.2 教育								11F 13:30 ~ 16:00	
1.3 新技術・複合新領域						12C 09:30 ~ 11:45			
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境							12C 09:00 ~ 11:30	12C 13:30 ~ 16:00	
1.5 計測技術・計測標準							12C 13:30 ~ 16:45		
1.6 超音波			12E 09:00 ~ 12:30						
2 放射線									
2.1 検出器デバイス開発	12E 09:15 ~ 12:00	12E 13:30 ~ 17:00		P01 13:30 ~ 15:30					
2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術						12E 09:30 ~ 12:00	12E 13:30 ~ 15:00		
2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 ※7.4 イオンビーム一般とのコードシェアセッション(CS.1)									
2.4 医用応用								12E 09:00 ~ 11:15	12E 13:30 ~ 16:00
2.5 放射線誘起蛍光体						12D 09:45 ~ 12:30	12D 13:45 ~ 18:00	12D 09:45 ~ 12:30	
3 光・フォトニクス									
3.1 光学基礎・光学新領域	1BN 09:30 ~ 12:00		12B 09:00 ~ 12:00	12B 13:30 ~ 17:15	P01 09:30 ~ 11:30	13P 13:30 ~ 17:15			
3.2 情報フォトニクス・画像工学			12A 10:00 ~ 11:30	12A 13:30 ~ 16:00	P02 09:30 ~ 11:30				
3.3 生体・医用光学			12C 09:00 ~ 11:45	12C 13:30 ~ 17:15	P03 09:30 ~ 11:30				
3.4 レーザー装置・材料			P01 09:30 ~ 11:30	13P 13:30 ~ 16:30					
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					13P 09:00 ~ 10:45				
3.5 超高速・高強度レーザー	13N 09:00 ~ 11:15	13N 13:30 ~ 16:15	13N 09:00 ~ 12:00	13N 13:30 ~ 15:45					
			P02 09:30 ~ 11:30						
3.6 レーザープロセッシング	13M 09:30 ~ 12:00		13M 09:00 ~ 12:00	13M 13:30 ~ 18:15	P04 09:30 ~ 11:30				
3.7 光計測技術・機器			1BL 09:15 ~ 11:50		P05 09:30 ~ 11:30		12B 09:15 ~ 12:00	12B 13:30 ~ 17:00	
3.8 テラヘルツ全般			P03 09:30 ~ 11:30		71A 09:00 ~ 11:30		11E 09:00 ~ 11:45	11E 13:30 ~ 16:15	
3.9 光量子物理・技術			P04 09:30 ~ 11:30				12P 09:30 ~ 11:45	12P 13:25 ~ 16:45	
3.10 フォトニック構造・現象		11E 13:30 ~ 15:30	11E 09:45 ~ 12:15		11E 09:45 ~ 12:15	11E 13:30 ~ 16:00			
		P06 16:00 ~ 18:00							
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						11F 16:15 ~ 18:45			
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション				11E 13:30 ~ 16:15					
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスのコードシェアセッション	11E 09:30 ~ 12:00								
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学			11F 09:00 ~ 12:00	11F 13:30 ~ 18:15	P06 09:30 ~ 11:30	11F 13:00 ~ 16:00	11F 09:00 ~ 12:00		
					11F 10:00 ~ 12:00				
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						11F 16:15 ~ 18:45			
3.12 半導体光デバイス	12A 09:00 ~ 12:00				P07 09:30 ~ 11:30				
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション				11E 13:30 ~ 16:15					
3.13 光制御デバイス・光ファイバー		12A 13:30 ~ 18:00	P05 09:30 ~ 11:30						
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					13P 09:00 ~ 10:45				
3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス		11F 13:30 ~ 17:45	1BJ 09:00 ~ 11:45		P08 09:30 ~ 11:30				
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスのコードシェアセッション	11E 09:30 ~ 12:00								
3.15 Optics and Photonics English Session		13M 13:30 ~ 18:15							
6 薄膜・表面									
6.1 強誘電体薄膜			12H 09:00 ~ 12:00	12H 13:30 ~ 16:30	12H 09:00 ~ 11:30	P01 13:30 ~ 15:30			
CS.6 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション							1BJ 09:00 ~ 11:30	1BJ 13:00 ~ 14:45	
6.2 カーボン系薄膜				12E 13:30 ~ 17:00		P02 13:30 ~ 15:30	12H 09:00 ~ 10:15	12H 13:30 ~ 16:45	
6.3 酸化物エレクトロニクス			P06 09:30 ~ 11:30		12G 09:30 ~ 11:45	12G 13:30 ~ 17:15			
6.4 薄膜新材料			P07 09:30 ~ 11:30			12H 13:30 ~ 18:00	12F 09:00 ~ 11:15		
6.5 表面物理・真空						P03 13:30 ~ 15:30			
CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション				12G 13:30 ~ 17:30					
6.6 プローブ顕微鏡			12F 09:30 ~ 11:45	12F 13:30 ~ 17:15		P04 13:30 ~ 15:30			

日程表 (分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術			P08 09:30 ~ 11:30					12M 13:00 ~ 17:00
7.2 電子ビーム応用							12M 09:00 ~ 12:00	
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	12N 09:00 ~ 11:45							
7.4 イオンビーム一般 ※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェアセッション(CS.1)						12B 13:30 ~ 17:45		
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 ※6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッション(CS.7)				12G 13:30 ~ 17:30				
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断	12G 09:00 ~ 11:30	12G 14:15 ~ 17:45				P08 16:00 ~ 18:00		
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理					61B 09:00 ~ 11:30	P09 16:00 ~ 18:00	61B 09:15 ~ 11:30	61B 13:00 ~ 15:30
8.3 プラズマナテクノロジー					P09 09:30 ~ 11:30			
CS.8 8.3 プラズマナテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション						12J 15:45 ~ 18:00		
8.4 プラズマライフサイエンス	12H 09:00 ~ 11:15	12H 14:15 ~ 17:00				P10 16:00 ~ 18:00		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野					P10 09:30 ~ 11:30	31B 13:30 ~ 17:45		
8.6 Plasma Electronics English Session		12G 17:45 ~ 18:15						
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		12H 13:00 ~ 13:45	71A 09:30 ~ 11:15					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体	12P 09:00 ~ 12:00					P05 13:30 ~ 15:30		
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート							31B 09:15 ~ 11:30	31B 13:00 ~ 16:30
CS.8 8.3 プラズマナテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション						12J 15:45 ~ 18:00		
9.3 ナノエレクトロニクス				12P 13:30 ~ 15:30		P05 13:30 ~ 15:30		
9.4 熱電変換	13P 09:00 ~ 12:00	13P 13:30 ~ 16:30	13P 09:00 ~ 11:00					
9.5 新機能材料・新物性						32A 13:30 ~ 17:45 P05 13:30 ~ 15:30	32A 09:00 ~ 11:45	
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	12K 09:00 ~ 12:00	12K 13:30 ~ 17:30					P01 09:30 ~ 11:30	
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術			12D 09:00 ~ 12:00	12D 13:30 ~ 17:30				
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術				1BJ 13:30 ~ 16:45				
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス					71B 09:00 ~ 11:30			71B 13:00 ~ 16:45
10.5 磁場応用	1BJ 09:00 ~ 11:45	1BJ 17:15 ~ 18:00						
11 超伝導								
11.1 基礎物性	P01 09:30 ~ 11:30		12P 09:30 ~ 11:00		12P 09:30 ~ 11:45	12P 13:30 ~ 15:45		
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長				12N 13:30 ~ 17:45				
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用				12N 09:00 ~ 11:45				
11.4 アナログ応用および関連技術							12N 09:00 ~ 12:00	
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用							12N 13:30 ~ 16:30	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御			1BB 09:30 ~ 11:45	P02 13:30 ~ 15:30				
12.2 評価・基礎物性		P01 13:30 ~ 15:30		1BB 13:30 ~ 18:45			1BC 09:00 ~ 12:00	1BC 13:30 ~ 16:30
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	P02 09:30 ~ 11:30		1BC 09:00 ~ 12:30	1BC 13:30 ~ 19:00	1BC 09:00 ~ 12:30	1BC 13:30 ~ 19:00		
12.4 有機EL・トランジスタ		P02 13:30 ~ 15:30			22B 09:00 ~ 11:30	22B 13:00 ~ 16:45	22B 09:00 ~ 11:45	
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		P03 13:30 ~ 15:30	22C 09:00 ~ 12:00	22C 13:00 ~ 16:30	22C 09:00 ~ 11:30	22C 13:00 ~ 16:30	22C 10:00 ~ 11:30	
CS.9 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション (タンデム)								22C 13:00 ~ 16:00
12.6 ナノバイオテクノロジー	P03 09:30 ~ 11:30		1BN 09:00 ~ 11:45	1BN 13:30 ~ 17:15	1BN 09:00 ~ 12:30			
12.7 医用工学・バイオチップ	P04 09:30 ~ 11:30		1BM 09:00 ~ 12:00	1BM 13:30 ~ 18:00	1BM 09:00 ~ 12:00		1BL 09:00 ~ 12:00	

日程表 (分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(金)		3月23日(土)		3月24日(日)		3月25日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション						P11 16:00 ~ 18:00	12J 09:00 ~ 12:00	
13.2 探索的材料物性・基礎物性				P03 13:30 ~ 15:30	12K 09:00 ~ 12:00	12K 13:30 ~ 15:15		
13.3 絶縁膜技術		12J 13:30 ~ 15:45				P12 16:00 ~ 18:00		
CS.6 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス /配線/集積化技術のコードシェアセッション							1BJ 09:00 ~ 11:30	1BJ 13:00 ~ 14:45
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	61C 09:00 ~ 11:30		12K 09:00 ~ 11:15	12K 13:30 ~ 18:00		P13 16:00 ~ 18:00		
13.5 デバイス/配線/集積化技術	12J 09:00 ~ 11:45		12J 09:00 ~ 12:15	12J 13:30 ~ 16:45		P14 16:00 ~ 18:00		
CS.6 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス /配線/集積化技術のコードシェアセッション							1BJ 09:00 ~ 11:30	1BJ 13:00 ~ 14:45
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス						P15 16:00 ~ 18:00	12K 09:30 ~ 12:00	12K 13:30 ~ 16:00
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価		P04 13:30 ~ 15:30		52A 13:00 ~ 18:15	52A 09:00 ~ 11:30	52A 13:00 ~ 18:15	52A 09:00 ~ 11:30	52A 13:00 ~ 14:30
13.8 光物性・発光デバイス				P04 13:30 ~ 15:30	12J 09:15 ~ 11:45			
13.9 化合物太陽電池			12L 09:30 ~ 12:15	12L 13:30 ~ 16:15		P06 13:30 ~ 15:30		
CS.9 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション (タンデム)								22C 13:00 ~ 16:00
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長		12N 13:30 ~ 16:30				P11 09:30 ~ 11:30		
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶							22A 09:00 ~ 10:15	
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎					22A 09:30 ~ 11:30	22A 13:30 ~ 15:30	P02 09:30 ~ 11:30	
15.4 III-V族窒化物結晶	21C 09:45 ~ 11:30	21C 13:00 ~ 18:00	21C 09:00 ~ 11:30	21C 13:00 ~ 18:15	21C 09:00 ~ 11:30	61C 16:45 ~ 18:00	21C 09:00 ~ 11:45	21C 13:30 ~ 15:00
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶			22A 09:45 ~ 11:30	22A 13:00 ~ 15:00	P12 09:30 ~ 11:30			
15.6 IV族系化合物 (SiC)		P05 13:30 ~ 15:30	52A 09:00 ~ 11:30					
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥					12F 09:00 ~ 12:00	12F 13:30 ~ 15:45	P04 09:30 ~ 11:30	
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス			12M 09:00 ~ 11:45	12M 13:30 ~ 17:00				
16.2 エナジーハーベスティング ※KS.3 半導体グリーンファブ研究会とのコードシェアセッション (CS.10)					12B 09:00 ~ 12:15		P05 09:30 ~ 11:30	
16.3 シリコン系太陽電池						12M 13:00 ~ 19:00		
CS.9 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション (タンデム)								22C 13:00 ~ 16:00
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		32A 13:00 ~ 15:45		32A 14:15 ~ 17:30				
		P07 16:00 ~ 18:00						
17.2 グラフェン		P07 16:00 ~ 18:00	32A 09:30 ~ 11:15	32A 13:00 ~ 14:15	32A 09:00 ~ 11:30			
17.3 層状物質			31B 09:30 ~ 11:30	31B 13:00 ~ 18:00	31B 09:00 ~ 11:30		71B 09:00 ~ 11:30	
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」			31A 09:00 ~ 11:30	31A 13:00 ~ 17:00	61A 09:45 ~ 11:30	P16 16:00 ~ 18:00	61A 09:30 ~ 11:30	61A 13:00 ~ 16:45
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」		P08 16:00 ~ 18:00		21B 13:15 ~ 17:00	21B 10:00 ~ 11:00	21B 13:00 ~ 16:30		
23 合同セッションN「インフオマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフオマティクス応用」	52A 09:00 ~ 11:45	52A 13:00 ~ 17:45				P07 13:30 ~ 15:30	61C 09:00 ~ 11:45	61C 13:00 ~ 16:30